

藤本卓嗣 (FUJIMOTO, Takashi)



修士論文「熱電能電界変調法による $\text{InGaO}_3(\text{ZnO})_m$ 薄膜トランジスタのチャンネル有効厚さ解析」
(Electric Field Thermopower Modulation Analyses of the Effective Thickness
 $\text{InGaO}_3(\text{ZnO})_m$ Thin Film Transistors)

在籍期間：2018.11 - 2022.3

学会発表 / Conference

[1] **藤本卓嗣**, 太田裕道, “熱電能電界変調法による $\text{InGaO}_3(\text{ZnO})_m$ 薄膜トランジスタの有効チャンネル厚さ解析”, 2022年 第69回 応用物理学会 春季学術講演会, 青山学院大学 相模原キャンパス+オンライン, 2022年3月22日-26日.

[2] **藤本卓嗣**, 太田裕道, “(B-14) 熱電能電界変調法による IGZO_m 薄膜トランジスタの動作特性解析”, 第57回 応用物理学会北海道支部 第18回 日本光学会北海道支部 合同学術講演会, Zoom オンライン, 2022年1月8日-9日.

[3] **藤本卓嗣**, 太田裕道, “熱電能電界変調法による IGZO_m 薄膜トランジスタの動作特性解析”, 令和3年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, online, 2021.11.18-19 (ポスター)

[4] **Takashi Fujimoto**, Hai Jun Cho, and Hiromichi Ohta, “Effect of heat treatment on the microstructure, electron transport properties and chemical bonding states of La-doped BaSnO_3 films”, The 21st RIES-Hokudai International Symposium 間 [ma], online, December 10-11, 2020 (poster).

[5] **藤本卓嗣**, ジョヘジュン, 太田裕道, “Laドーピング BaSnO_3 薄膜の微細構造, 化学結合状態, 電子輸送特性に及ぼす熱処理の影響”, 令和2年度 日本セラミックス協会 東北北海道支部 研究発表会, online, November 13-14, 2020.

[6] 藤本卓嗣, ジョヘジュン, 太田裕道, “新しい透明酸化物半導体 La ドープ BaSnO₃ 薄膜 –微細構造, 化学結合状態, 電子輸送特性に及ぼす熱処理の影響–”, 第 5 回 北海道大学 部局横断シンポジウム–新世代の融合研究を目指して–, 北海道大学, 2020 年 10 月 19 日 (ポスター)

[7] Takashi Fujimoto, Hai Jun Cho, and Hiromichi Ohta, “Effect of heat treating on electronic and structural properties of lightly doped epitaxial La_xBa_{1-x}SnO₃ films”, 2019 International Symposium of Research Institute for Electronic Science (RIES), Hokkaido University & Center for Emergent Functional Matter Science (CEFMS), Hokkaido University, Sapporo, Japan, December 3-4, 2019. (Poster)

[8] Takashi Fujimoto, Hai Jun Cho, and Hiromichi Ohta, “Effect of heat treating on electronic and structural properties of lightly doped epitaxial La_xBa_{1-x}SnO₃ films”, The 20th RIES-HOKUDAI International Symposium, Hokkaido University, Sapporo, Japan, December 2-3, 2019. (Poster)